

# BW767-G 型 GaN FET 用驱动器芯片

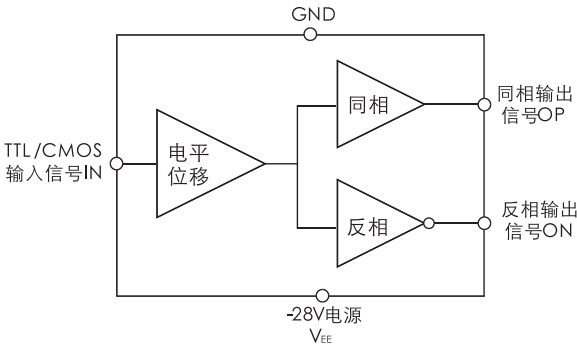
## 性能特点

- 输入信号：兼容 TTL/CMOS 信号
- 输出信号： $V_{EE}$  (-48V~-10V) / 0V
- 开关延时：40ns
- 静态电流： $\leq 1.5\text{mA}$
- 芯片背面不能接地

## 产品概述

BW767-G 采用 CMOS 工艺制造，由单电源  $V_{EE}$  (-48V~-10V) 供电，可将 1 位 TTL 脉冲输入信号转换为 1 位互补输出  $V_{EE}$  到 0V 的脉冲信号。该产品具有功耗低、响应速度快，使用方便等特点，可应用于驱动 GaN FET 类开关器件。

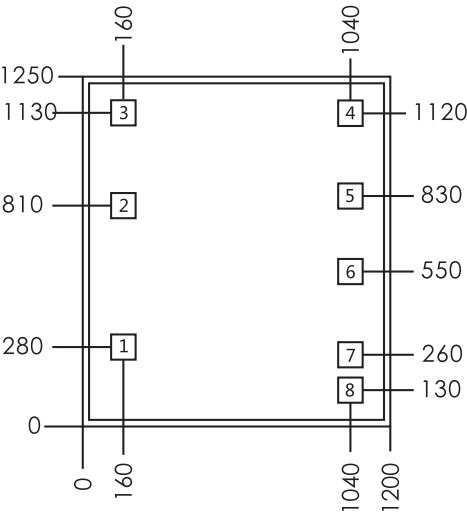
## 功能框图



## 电性能表 ( $T_A=+25^{\circ}\text{C}$ , 0/+5V 控制, 负载为 2.2pF 电容到地, $V_{EE}=-28\text{V}$ )

| 参数名称                           | 符号          | 条件                       | 最小值   | 典型值 | 最大值   | 单位 |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------|----|
| 电源电压                           | $V_{EE}$    | -                        | -48   | -28 | -10   | V  |
| 静态电流                           | $ I_{OP} $  | $V_{IN}=5\text{V}$       | -     | 1.2 | 1.5   | mA |
| 输出高电平电压                        | $V_{OH}$    | -                        | -0.2  | 0   | 0.2   | V  |
| 输出低电平电压                        | $V_{OL}$    | -                        | -28.2 | -28 | -27.8 | V  |
| 开关延时 (输入 TTL 的 50% 到输出信号的 50%) | $T_{ONDP}$  | $f=1\text{MHz}$ , 同相输出开启 | -     | 27  | 40    | ns |
|                                | $T_{OFFDP}$ | $f=1\text{MHz}$ , 同相输出关断 | -     | 38  | 45    | ns |
| 上升时间                           | $T_{RP}$    | $f=1\text{MHz}$ , 同相输出   | -     | 15  | 25    | ns |
| 下降时间                           | $T_{FP}$    | $f=1\text{MHz}$ , 同相输出   | -     | 15  | 25    | ns |

## 外形尺寸



## 键合压点定义

| 压点编号 | 功能符号     | 功能描述                                     |
|------|----------|------------------------------------------|
| 1、3  | $V_{EE}$ | 电源 (-48V~-10V)，两个引脚在芯片内部已短接              |
| 2    | TTL      | TTL 输入端                                  |
| 4、8  | GND      | 地，两个引脚在芯片内部已短接                           |
| 5、7  | ON       | 反相输出 (输入 0V, 输出 0V; 输入 5V, 输出 $V_{EE}$ ) |
| 6    | OP       | 同相输出 (输入 0V, 输出 $V_{EE}$ ; 输入 5V, 输出 0V) |